

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

Declaration and Power of Attorney For Patent Application

特許出願宣言書及び委任状

Japanese Language Declaration

日本語宣言書

以下の氏名を発明者として、私は以下の通り宣言します。

As a below named inventor, I hereby declare that:

私の住所、私官籍、国籍は下記の私の氏名の後に記載されています。

My residence, post office address and citizenship are as stated next to my name.

下記の名称の発明に関して請求範囲に記載され、特許出願している発明内容について、私が最初かつ唯一の発明者（下記氏名が一つの場合）もしくは最初かつ共同発明者である（下記の名称が複数の場合）信じています。

I believe I am the original, first and sole inventor (if only one name is listed below) or an original, first and joint inventor (if plural names are listed below) of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought on the invention entitled

METHOD OF MANUFACTURING A

SEMICONDUCTOR DEVICE

上記発明の明細書（下記の欄でX印がついていない場合は、書に添付）は、

the specification of which is attached hereto unless the following box is checked:

____月____日に提出され、米国出願番号または特許協定条約国際出願番号を____とし、
（該当する場合）____に訂正されました。

☒ was filed on October 14, 1998
as United States Application Number or
09/172,300 PCT International Application Number
and was amended on
____ (if applicable).

私は、特許請求範囲を含む上記訂正後の明細書を検討し、内容を理解していることをここに表明します。

I hereby state that I have reviewed and understand the contents of the above identified specification, including the claims, as amended by any amendment referred to above.

私は、連邦規則第37編第1条56項に定義されるとおり、特許資格の有無について重要な情報を開示する義務があることを認めます。

I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, Section 1.56.

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

Japanese Language Declaration

(日本語宣言書)

私は、米国法典第35編119条(a)-(d)項又は365条(b)項に基づき下記の、外国以外の国の少なくとも一ヶ国を指定している特許協力条約365(a)項に基づく国際出願、又は外国での特許出願もしくは発明者証の出願についての外国優先権をここに主張するとともに、優先権を主張している、本出願の前に出願された特許または発明者証の外国出願を以下に、枠内をマークすることで、示しています。

Prior Foreign Application(s)

外国での先行出願

09-308043

(Number)

(番号)

10-152305

(Number)

(番号)

Japan

(Country)

(国名)

Japan

(Country)

(国名)

October 21, 1997

(Day/Month/Year Filed)

(出願年月日)

May, 16, 1998

(Day/Month/Year Filed)

(出願年月日)

Priority Not Claimed

優先権主張なし

☐☐

私は、第35編米国法典119条(e)項に基づいて下記の米特許出願規定に記載された権利をここに主張いたします。

(Application No.)

(出願番号)

(Filing Date)

(出願日)

(Application No.)

(出願番号)

(Filing Date)

(出願日)

私は、下記の米国法典第35編120条に基づいて下記の米特許出願に記載された権利、又は米国を指定している特許協力条約365条(c)項に基づく権利をここに主張します。また、本出願の各請求範囲の内容が米国法典第35編112条(1)項又は特許協力条約で規定された方法で先行する米国特許出願に開示されていない限り、その先行米国出願書提出日より本出願書の日本国内または特許協力条約国際提出日よりの期間中に入手された、連邦規則法典第37編1.105条6項で定義された特許資格の有無に関する重要な情報について開示義務があることを認識しています。

(Application No.)

(出願番号)

(Filing Date)

(出願日)

(Status: Patented, Pending, Abandoned)

(状況: 特許許可済、係属中、放棄済)

(Application No.)

(出願番号)

(Filing Date)

(出願日)

(Status: Patented, Pending, Abandoned)

(状況: 特許許可済、係属中、放棄済)

私は、私自身の知識に基づいて本宣言書中で私が行なう表明が真実であり、かつ私の入手した情報と私の信じていることに基づき表明が全て真実であると信じていること、さらに故意になされた虚偽の表明及びそれと同等の行為は米国法典第18編第1001条に基づき、罰金または拘禁、もしくはその両方より処罰されること、そしてそのような故意による虚偽の表明を行なえば、出願した、又は既に許可された特許の有効性が失われることを認識し、よってここに上記のごとく宣誓を致します。

I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code, Section 119(e) of any United States provisional application(s) listed below.

I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code, Section 120 of any United States application(s), or 365(c) of any PCT international application designating the United States, listed below and, insofar as the subject matter of each of the claims of this application is not disclosed in the prior United States or PCT international application in the manner provided by the first paragraph of Title 35, United States Code Section 112, I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, Section 1.56 which became available between the filing date of the prior application and the national or PCT international filing date of application.

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

Japanese Language Declaration

(日本語宣言書)

私は、私は下記の発明者として、本出願に関する一切の
手続を本特許事務所に対して遂行する権限にまたは代理人
として、下記の者を指名いたします。(特許出、または代理
人の三名及び登録番号を明記のこと)

POWER OF ATTORNEY: As a named inventor, I hereby appoint
the following attorney(s) and/or agent(s) to prosecute this
application and transact all business in the Patent and Trademark
Office connected therewith (list name and registration number)

Daniel W. Sixbey, (Reg. No. 20,932)
Gerald J. Ferguson, Jr. (Reg. No. 23,016)
Joan K. Lawrence (Reg. No. 29,940)
Evan R. Smith (Reg. No. 35,683)

Suzart J. Friedman (Reg. No. 24,312)
David S. Safran (Reg. No. 27,997)
Donald R. Sudebaker (Reg. No. 32,815)
Tim L. Brackett (Reg. No. 36,092)

Charles M. Leedom, Jr. (Reg. No. 26,477)
Thomas W. Cole (Reg. No. 28,290)
Jeffrey L. Costella (Reg. No. 35,483)
Eric J. Robinson (Reg. No. 38,285)

寄附送付元

Send Correspondence to:

SDGBEY, FRIEDMAN, LEEDOM & FERGUSON, P.C.
2010 Corporate Ridge, Suite 600
McLean, Virginia 22102

SDGBEY, FRIEDMAN, LEEDOM & FERGUSON, P.C.
2010 Corporate Ridge, Suite 600
McLean, Virginia 22102

直接通話元: (名前及び電話番号)

Direct Telephone Calls to: (name and telephone number)

Mr. erald J. Ferguson Jr.
(703)790-9110

Mr. Gerald J. Ferguson Jr.
(703)790-9110

第一発明者	Full name of sole or first inventor		
名	Shunpei YAMAZAKI	Date	
日付	Inventor's signature		
住所	Residence		November 18, 1998
国籍	Tokyo, Japan		
私書	Citizenship		
	Japanese		
	Post Office Address		
	c/o SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY CO., LTD.		
	398, Hase, Atsugi-shi, Kanagawa-ken 243-0036		
	Japan		
第二共同発明者	Full name of second joint inventor, if any		
発明者の署名	Hisashi OHTANI	Date	
日付	Inventor's signature		
住所	Residence		Nov 19, 1998
国籍	Kanagawa, Japan		
私書	Citizenship		
	Japanese		
	Post Office Address		
	c/o SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY CO., LTD.		
	398, Hase, Atsugi-shi, Kanagawa-ken 243-0036		
	Japan		

(第三出願の共同発明者についても同様に記載し、署名をす
ること)

(Supply similar information and signature for third and
subsequent joint inventors.)

☐ Please see attached page 3a for names, addresses and signatures of
additional inventors, if any.